

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年6月7日現在

機関番号:14401
研究種目:若手研究(A)
研究期間:2011~2012
課題番号:23686091
研究課題名(和文)
貴金属ナノ粒子を担持したバルクナノ熱電材料の創出と熱電特性
研究課題名(英文)
Synthesis and Characterization of Au nanoparticle-Supported Bulk Thermoelectric
Materials
研究代表者
黒崎 健 (KUROSAKI KEN)
大阪大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:90304021

研究成果の概要(和文):

SbBiTe バルク合金は、室温付近において性能を発揮する高性能熱電材料である。一方、熱電 材料の性能指数 ZTを向上させるために重要なことは、高い電気伝導率を保ったまま格子熱伝導 率 κ_{lat} を減少させる、つまり電子は散乱されないがフォノンは散乱される状況を、材料中につ くりだすことにある。本研究では、 γ 線照射法を用いて、Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃母相中にAuとAuTe₂のナ ノ粒子が均一に分散した完全なナノコンポジット材料を作製した。主に、ナノ粒子と母相との 界面におけるフォノン散乱により、ナノコンポジット材料の κ_{lat} は大きく減少し、結果、ZT が 上昇した。AuとAuTe₂のナノ粒子を担持した Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃バルク熱電材料の最大の ZT は 423 K で1.01 に達した。この値は、通常のSb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃バルク熱電材料の ZTよりも 18%高い値である。

研究成果の概要(英文):

SbBiTe bulk alloys have been some of the most efficient thermoelectric (TE) materials near room temperature. On the other hand, the way to enhance the dimensionless figure of merit (ZT) is to decrease the lattice thermal conductivity (κ_{lat}) of the material, while maintaining a high electrical conductivity, i.e., to create a situation in which phonons are scattered but electrons are unaffected. Here we synthesized a complete nanocomposite using γ -ray irradiation, in which Au/AuTe₂ nanoparticles are dispersed uniformly without aggregation in the Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃ matrix. The κ_{lat} was significantly reduced mainly due to the increased number of interfaces for phonon scattering between the nanoparticles and the matrix phase, thereby resulting in clear enhancement of ZT. The maximum ZT value of the Au/AuTe₂ nanoparticle-supported Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃ nanocomposite was 1.01 at 423 K, which is about 18% higher than the maximum ZT value of Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃.

		(金額単位:円)	
	直接経費	間接経費	合 計
2011 年度	15, 400, 000	4, 620, 000	20, 020, 000
2012 年度	4, 400, 000	1. 320, 000	5, 720, 000
年度			
年度			
年度			
総計	19, 800, 000	5, 940, 000	25, 740, 000

交付決定額

研究分野:環境エネルギー材料工学 科研費の分科・細目:材料工学・金属物性 キーワード:熱電材料

1. 研究開始当初の背景

現在、一次エネルギーの約七割が排熱とし て捨てられている。この莫大な未利用エネル ギーを有効に利用することは、地球温暖化問 題を含む将来の環境・エネルギー問題を解決 するための重要な解決策の一つである。材料 に温度差を設けることで生じる熱起電力(ゼ ーベック効果)を利用して熱と電気の間で直 接的なエネルギー変換を実現する熱電変換 は、機械的な稼動部が無いため信頼性が高く、 また、発電時に廃棄物を出さないため環境に も優しい。このため、産業用から民生用まで 分散的に存在する排熱エネルギーを電力に 変換する究極の分散熱エネルギー有効利用 技術として、近年注目を集めている。

熱電発電システムの産業化のためには、熱 電エネルギー変換を担う熱電材料の高性能 化が必要不可欠である。熱電材料の性能は無 次元性能指数(ZT)と呼ばれる指標によって 決定される。ZTは、材料のゼーベック係数(S)、 電気伝導率(σ)、熱伝導率(κ)、絶対温度 (T)を用いて、ZT = $S \sigma T / \kappa$ とあらわされ る。したがって、熱電材料の高性能化のため には、高いSと σ に加えて低い κ が要求され る。商用バルク熱電材料のZT の値は最大で も0.8 程度である。

ZT を向上させるためのアプローチとして、 今最も注目されていることは、材料のナノ構 造化である。MIT の Dresselhaus 教授は、材 料をナノ構造化することで生じる量子サイ ズ効果により、ゼーベック係数の増大と格子 熱伝導率の低減が同時に起こり、ZTが大幅に 向上すると予測した。実際、Bi₂Te₃と Sb₂Te₃ の超格子構造や PbTe と PbSeTe の量子ドット 構造などにおいて、ZTの向上が達成されてい る。しかしながら、このような超格子薄膜構 造は、実用化に向けてのスケールアップに多 大な労力や費用がかかるというデメリット がある。たとえ材料としての性能は申し分な くとも、このような薄膜材料を排熱回収型熱 電デバイスに搭載することは現実的な選択 肢とはなりえない。作製が容易で大量生産に 向くバルク体においてナノ組織を実現する、 つまりバルクナノ材料を創出することが重 要となる。

バルクナノ材料にはいくつか種類がある が、その中でもバルク体中に均一にシングル ナノメートルサイズの粒子が分散した組織 (この場合、ナノ粒子の種類は特に選ばな い)は、電気的特性に多大な影響を与えるこ となく熱伝導率のみが選択的に低減された 理想的な熱電材料になりうると期待されて いる(図1)。このようなバルクナノ材料の 作成方法としては、母相を構成するマイクロ 粒子と分散相となるナノ粒子をボールミル で混合した後ホットプレスで焼結する手法 が一般的であるが、ボールミル時にナノ粒子 が凝集したり、ホットプレス時にナノ粒子が 成長したりして、均一なナノ組織を作製する ことは極めて難しい。



図 1 バルク体の中に均一にシングルナノ 粒子が分散した組織のイメージ(ナノ粒子に よってフォノンは散乱されるが電子は散乱 されずに素通りする。この結果、電気伝導率 を高く保ったまま熱伝導率のみを低減でき る。)

2. 研究の目的

そこで、本研究では、マイクロ粒子表面に 均一に貴金属ナノ粒子を担持出来る「放射線 照射法」と、ナノ粒子を高密度バルク体に焼 結出来る「ホットプレス」を組み合わせるこ とで、熱電材料中に貴金属ナノ粒子を均一に 分散させたバルクナノ材料を作製し、熱電特 性の向上を図ることを目的とする。

熱電材料としては、Bi₂Te₃系材料を対象とし、これに放射線照射法で実績のある金、銀、白金のナノ粒子を付与する。ナノ粒子の種類、量、サイズ、分散形態と熱電特性の相関を詳細に研究することで、熱電特性が最も向上しうる最適条件を確立する。

3. 研究の方法

本研究では、Au ナノ粒子が Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃相の中に均一に分散されている多結晶バルク 試料を、ガンマ線照射を利用して作製し、熱 電特性を評価した。

ガンマ線照射は水溶液雰囲気で行われる ため、担体粒子は水溶液中で安定な Sb を対 象にした。Au イオンの原料には HAuCl₄を用い、 Sb 粉末、ポリマーとアルコールを加えた水溶 液にコバルト 60 線源を用い、線量率 0.5 kGy/h で 6 時間照射した。そこで得られた Au ナノ粒子を担持した Sb 粒子 (Sb_Au) を Bi、 Te と 1.6:0.4:3 の化学量論比で秤量してメ カニカルアロイを施した。その後、合金化さ れた粉末を高温で焼結した。得られたバルク 試料(Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au)に対して X線回折(XRD) 測定、FE-SEM 観察、HAADF-STEM 分析、電気 抵抗率・ゼーベック係数・熱拡散率・ホール 効果測定を行い、熱電特性を評価した。

4. 研究成果

ガンマ線照射後の Sb_Au 粒子と焼結後の Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃_Auバルク試料の破断面のFE-SEM 観察結果を図 2(a)と(b)に示す。図 2(a)よ り、Au ナノ粒子が Sb 粒子表面に分散して担 持されている様子が確認できる。また、図 2(b)より、焼結後にも Au ナノ粒子が Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃相の中に均一に分散されている ことが確認できる。



図 2 (a) Sb_Au 粒子と(b) Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au バルク試料の破断面の FE-SEM 観察像

次に、図 3 に Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au の焼結前後の XRD パターンを示す。焼結前の試料の XRD パ ターンにおけるピークは、過去に報告されて いる文献におけるピークとよく一致したが、 焼結後には AuTe₂ のピークと不明なピークが 見られた。また、図 2(b)において明確に見 られた Au ナノ粒子に相当するピークは確認 できなかった。



図 3 Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au バルク試料の(a) 焼結 前と(b) 焼結後の XRD パターン

Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au 中の Au の存在形態を確認 するため、HAADF-STEM 観察と EDX 線分析を行 った。その結果を図 4 に示す。HAADF-STEM イメージから、試料中に存在する二種類のナ ノ粒子が確認できる。図 4(a)と(b)に示した 線 1 と 2 上の EDX ラインスキャン分析から、 一つ目の粒子は主に Au で構成されて、二つ 目の粒子は主に Au と Te で構成されているこ と が わ か っ た 。 以 上 の 結 果 か ら Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au バルク試料中には、Au と AuTe₂ の二つのナノ粒子が存在するといえる。



図 4 HAADF-STEM イメージと EDX 線分析結果

図 5 に、本研究で作製した Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃₋Au バルク試料と、比較のため金ナノ粒子を担持 していない Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃ バルク試料の電気抵 抗率、熱伝導率、ゼーベック係数、性能指数 ZTの温度依存性を示す。Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Auバル ク試料の電気抵抗率とゼーベック係数は金 ナノ粒子を担持していない Sb1 6Bi0 4Te3 バル ク試料と比べて小さい値を示した。室温での ホール効果測定の結果から、Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au バルク試料のキャリア濃度が金ナノ粒子を 担持していない Sb1 6Bi0 4Te3 バルク試料のそ れよりも大きいことを確認している。今回の 電気抵抗率とゼーベック係数の結果は、この キャリアキャリア濃度の増加が主な原因で あると思われる。一方、熱伝導率に関しては、 全温度領域において Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃_Au バルク試 料の熱伝導率が金ナノ粒子を担持していな い Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃ バルク試料の熱伝導率よりも 低い値となった。特に、点線で示した格子熱 伝導率が大幅に減少していることがわかる。 その原因は、微細構造の観察から確認された Au と AuTe2のナノ粒子が効率的にフォノンを 散乱させたためだと思われる。以上の結果か らZTを算出したところ、Auと AuTe2のナノ粒 子を担持した Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃ バルク熱電材料の 最大の ZTは 423 K で 1.01 に達した。この値 は、通常の Sb₁₆Bi₀₄Te₃バルク熱電材料の ZT よりも18%高い値であった。

本研究により、ガンマ線照射法で Au ナノ 粒子を担持させることで、熱電特性が向上す ることが明確に示された。



図 5 本研究で作製した Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃Au バル ク 試料 と 金 ナ ノ 粒 子 を 担 持 し て い な い Sb_{1.6}Bi_{0.4}Te₃ バルク 試料の 電気抵抗率、熱伝導 率、 ゼーベック係数、性能指数 *ZT* の 温度依 存性

5. 主な発表論文等 〔雑誌論文〕(計24件) ① Ken Kurosaki and Shinsuke Yamanaka, Low-thermal-conductivity group 13 chalcogenides as high-efficiency thermoelectric materials, Phys. Status Solidi A, 査読有, 210, 82-88 (2013). 2 Theerayuth Plirdpring, <u>Ken Kurosaki</u>, Atsuko Kosuga, Tristan Day, Samad Firdosy, Vilupanur Ravi, G. Jeffrey Snyder, Adul Harnwunggmoung, Tohru Sugahara, Yuji Ohishi, Hiroaki Muta, and Shinsuke Yamanaka, Chalcopyrite CuGaTe₂: A high-efficiency bulk thermoelectric material, Adv. Mater., 查読有, 24, 3622-3626 (2012).

③ Do-young Jung, <u>Ken Kurosaki</u>, Tohru Sugahara, Yuji Ohishi, Hiroaki Muta, and Shinsuke Yamanaka, Effect of phase transition on the thermoelectric properties of Ag_2 Te, Mater. Trans., 査読 有, 53, 1216-1219 (2012).

〔学会発表〕(計15件)

①<u>Ken Kurosaki</u>、Thermoelectric properties of Tl-filled CoSb₃ Based Skutterudites、 IUMRS-International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 2012)、 2012. 9. 23-28、Pacifico Yokohama ②<u>黒崎健、カルコパイライト型化合物 CuGaTe₂の高温熱電特性、日本熱電学会第9 回学術講演会、2012. 8. 27-28、東京工業大学 ③<u>Ken Kurosaki</u>、Thermoelectric properties of the Cu-Ga-Te ternary compounds、E-MRS 2011 SPRING MEETING、2011. 5. 12、Congress Center, Nice, France</u>

〔図書〕(計3件)

 ①<u>黒崎健</u>、牟田浩明、山中伸介(分担執筆)、 CMC 出版、熱電変換技術の基礎と応用 クリ ーンなエネルギー社会を目指して、(2011)、 130-136

〔産業財産権〕 ○出願状況(計1件) 名称:熱電変換材料、熱電変換素子およびその作製方法 発明者:<u>黒崎健</u>、山中伸介、牟田浩明、大石佑治、Theerayuth Plirdpring、Adul Harnwunggmoung 権利者:国立大学法人大阪大学 種類:特許 番号:特願 2011-149055 出願年月日:2011年7月5日 国内外の別:国内

〔その他〕 http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/view?1 =ja&u=2729&n=kurosaki&kc=1&sm=name&s1=j a&sp=1

http://www.see.eng.osaka-u.ac.jp/seems/ seems/ http://thermoelectric-nanosilicon.jp/ 6. 研究組織 (1)研究代表者 黒崎 健 (KUROSAKI KEN) 大阪大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:90304021 (2)研究分担者 なし。 (3) 連携研究者 山中 伸介 (YAMANAKA SHINSUKE) 大阪大学・大学院工学研究科・教授 研究者番号:00166753 牟田 浩明 (MUTA HIROAKI) 大阪大学・大学院工学研究科・助教 研究者番号:60362670 大石 佑治 (OHISHI YUJI) 大阪大学・大学院工学研究科・助教 研究者番号:20571558 清野 智史 (SEINO SATOSHI) 大阪大学・大学院工学研究科・講師 研究者番号:90432517 石丸 学 (ISHIMARU MANABU) 大阪大学・産業科学研究所・准教授 研究者番号:00264086 Doyoung Jung (DOYOUNG JUNG) 大阪大学・大学院工学研究科・博士後期課 程学生 研究者番号:なし Theeravuth Plirdpring 大阪大学・大学院工学研究科・博士後期課 程学生 研究者番号:なし Adul Harnwunggmoung 大阪大学・大学院工学研究科・博士後期課 程学生 研究者番号:なし